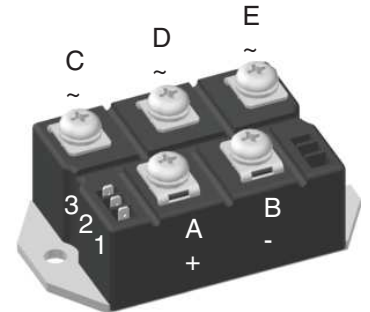
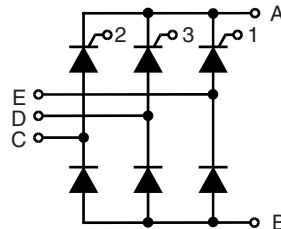


Three Phase Half Controlled Rectifier Bridge, B6HK

$$I_{dAVM} = 110/167 \text{ A}$$

$$V_{RRM} = 1200-1600 \text{ V}$$

V_{RSM} V_{DSM} V	V_{RRM} V_{DRM} V	Type
1300	1200	VVZ 110-12io7
1700	1600	VVZ 175-12io7 VVZ 175-16io7



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings			
		VVZ 110	VVZ 175		
I_{dAV}	$T_C = 85^\circ\text{C}$; module per leg	110	167	A	
I_{FRMS}, I_{TRMS}		58	89	A	
I_{FSM}, I_{TSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$; $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	1150	1500	A
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	1230	1600	A
I^2t	$T_{VJ} = T_{VJM}$; $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	1000	1350	A
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	1070	1450	A
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$; $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	6600	11200	A ² s
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	6280	10750	A ² s
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$; $V_{DR} = 2/3 V_{DRM}$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	5000	9100	A ² s
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	4750	8830	A ² s
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$ repetitive, $I_T = 50 \text{ A}$ $f = 400 \text{ Hz}$, $t_p = 200 \mu\text{s}$ $V_D = 2/3 V_{DRM}$		150		A/ μs
	$I_G = 0.3 \text{ A}$, non repetitive, $di_G/dt = 0.3 \text{ A}/\mu\text{s}$, $I_T = 1/3 \cdot I_{dAV}$		500		A/ μs
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$; $V_{DR} = 2/3 V_{DRM}$ $R_{GK} = \infty$; method 1 (linear voltage rise)		1000		V/ μs
V_{RGM}			10		V
P_{GM}	$T_{VJ} = T_{VJM}$	$t_p = 30 \mu\text{s}$	≤ 10		W
	$I_T = I_{TAVM}$	$t_p = 500 \mu\text{s}$	≤ 5		W
		$t_p = 10 \text{ ms}$	≤ 1		W
P_{GAVM}			0.5		W
T_{VJ}			-40...+125		$^\circ\text{C}$
T_{VJM}			125		$^\circ\text{C}$
T_{stg}			-40...+125		$^\circ\text{C}$
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $t = 1 \text{ min}$		2500		V~
	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$ $t = 1 \text{ s}$		3000		V~
M_d	Mounting torque (M6)		5±15 %		Nm
	Terminal connection torque (M6)		5±15 %		Nm
Weight	typ.		300		g

Features

- Package with screw terminals
- Isolation voltage 3000 V~
- Planar passivated chips
- UL registered E72873

Applications

- Input rectifier for PWM converter
- Input rectifier for switch mode power supplies (SMPS)
- Softstart capacitor charging

Advantages

- Easy to mount with two screws
- Space and weight savings
- Improved temperature and power cycling

Data according to IEC 60747 and refer to a single thyristor/diode unless otherwise stated.

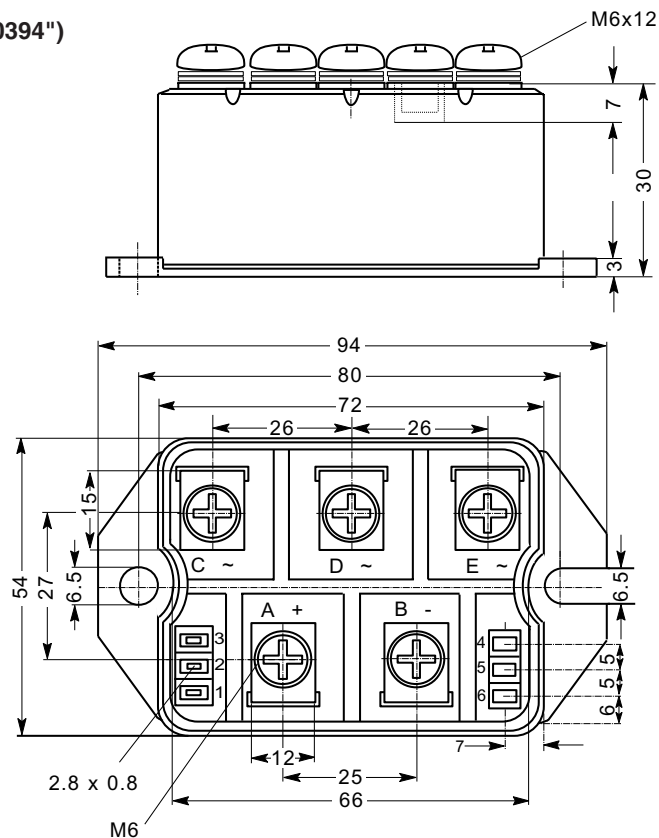
Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

20200117c

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		VVZ 110	VVZ 175	
$I_{R'} I_D$	$V_R = V_{RRM}; V_D = V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	≤ 5	mA
		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	≤ 0.3	mA
$V_F V_T$	$I_F I_T = 200 \text{ A}, T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	≤ 1.75	1.57	V
V_{T0}	For power-loss calculations only	0.85	0.85	V
r_T	($T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$)	6	3.5	mΩ
V_{GT}	$V_D = 6 \text{ V};$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	≤ 1.5	V
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	≤ 1.6	V
I_{GT}	$V_D = 6 \text{ V};$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	≤ 100	mA
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	≤ 200	mA
V_{GD}	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	≤ 0.2	0.2	V
I_{GD}	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	≤ 5	5	mA
I_L	$I_G = 0.3 \text{ A}; t_G = 30 \mu\text{s}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $di_G/dt = 0.3 \text{ A}/\mu\text{s}$	≤ 450	450	mA
I_H	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}; V_D = 6 \text{ V}; R_{GK} = \infty$	≤ 200	200	mA
t_{gd}	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}; V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$ $I_G = 0.3 \text{ A}; di_G/dt = 0.3 \text{ A}/\mu\text{s}$	≤ 2	2	μs
R_{thJC}	per thyristor (diode); DC current per module	0.65	0.46	K/W
		0.108	0.077	K/W
R_{thJH}	per thyristor (diode); DC current per module	0.8	0.55	K/W
		0.133	0.092	K/W
d_s	Creeping distance on surface	10	10	mm
d_A	Creepage distance in air	9.4	9.4	mm
a	Max. allowable acceleration	50	50	m/s ²

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")


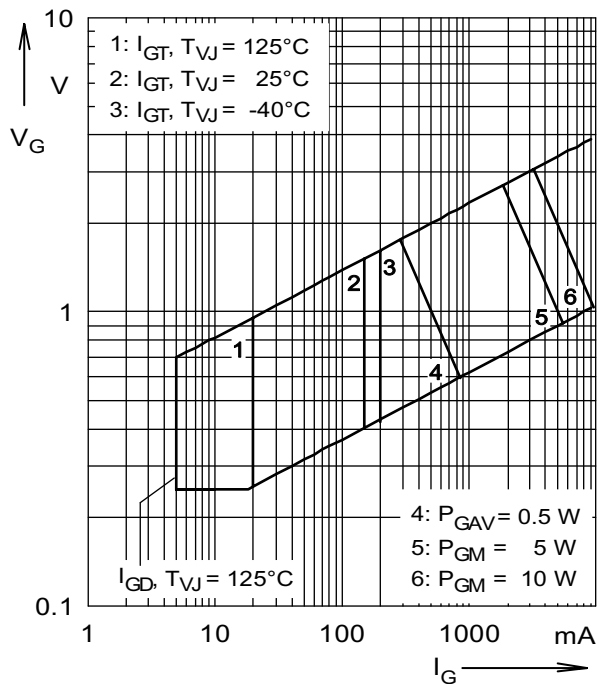


Fig. 1 Gate trigger characteristics

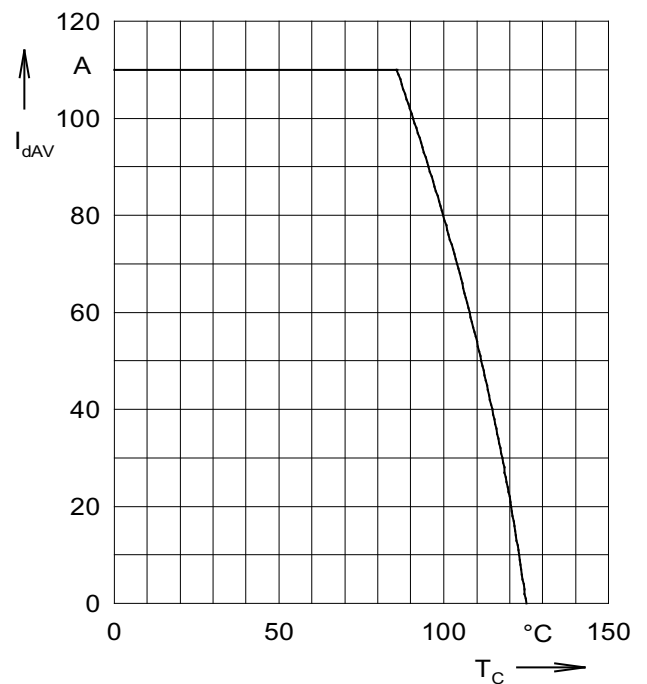


Fig. 2 DC output current at case temperature

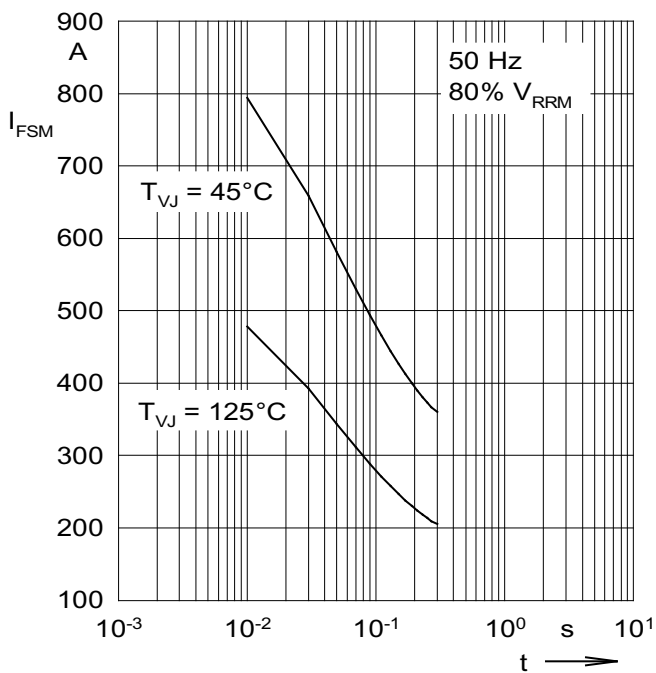


Fig. 3 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t : duration

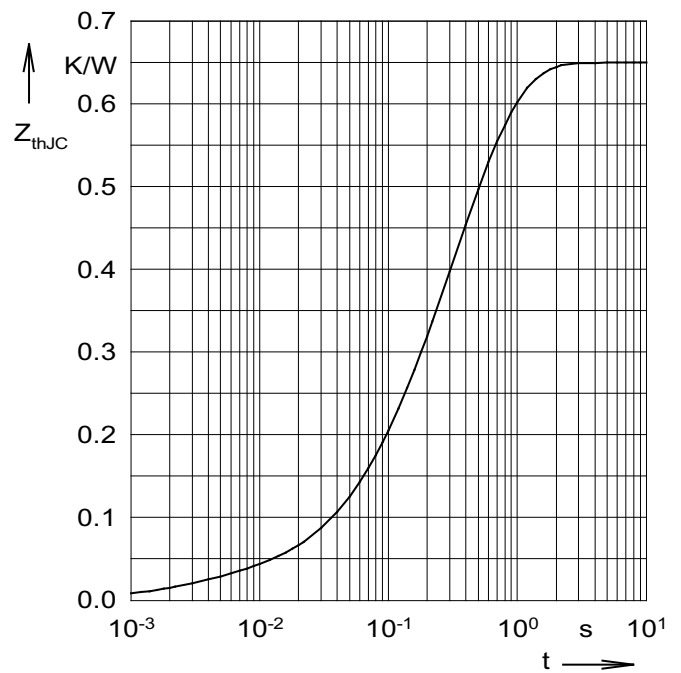


Fig. 4 Transient thermal impedance junction to case (per leg)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.